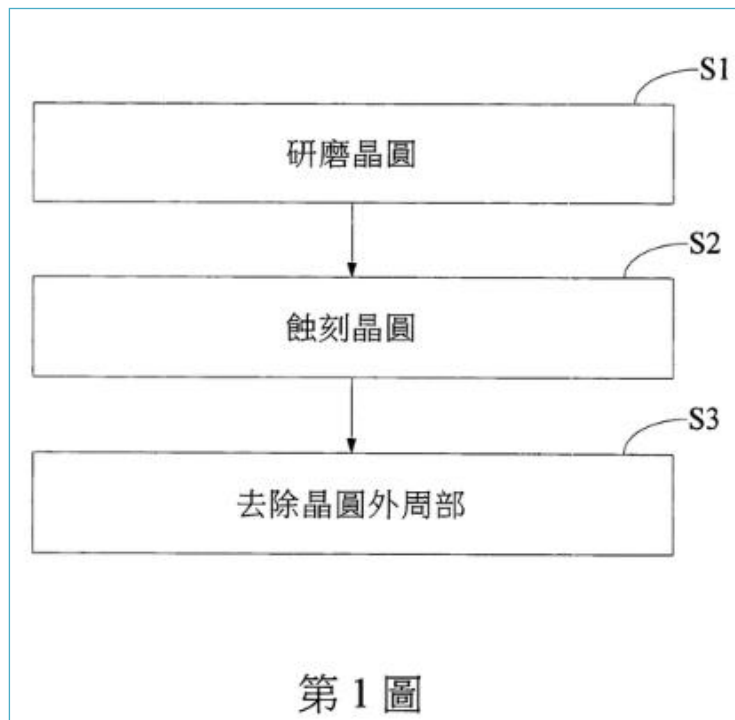


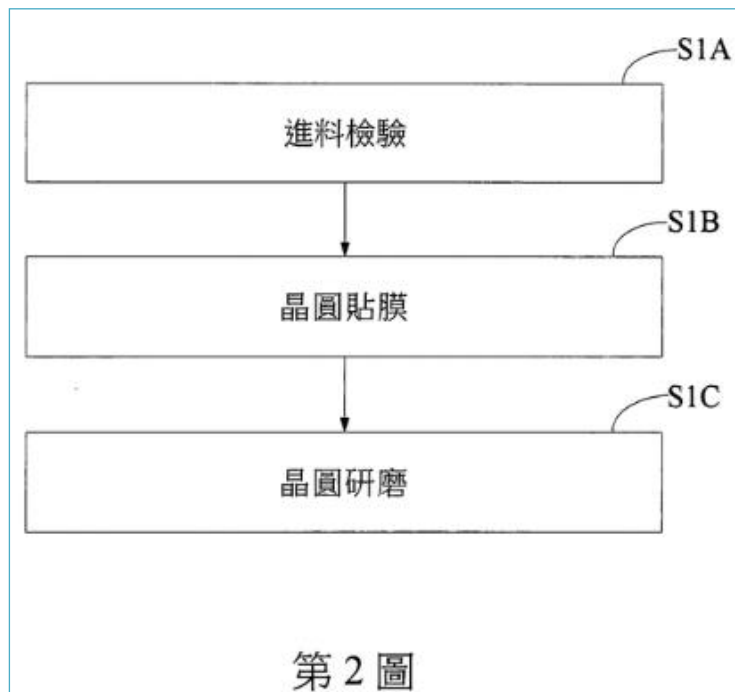
109 年度民專上字第 36 號附圖

附圖一：系爭專利圖式

1. 第 1 圖為一種晶圓薄化製程之流程圖



2. 第 2 圖為太鼓製程之流程圖



3.第 3 圖為濕式蝕刻之流程圖



附圖二：系爭製程之相關影片截圖



2.

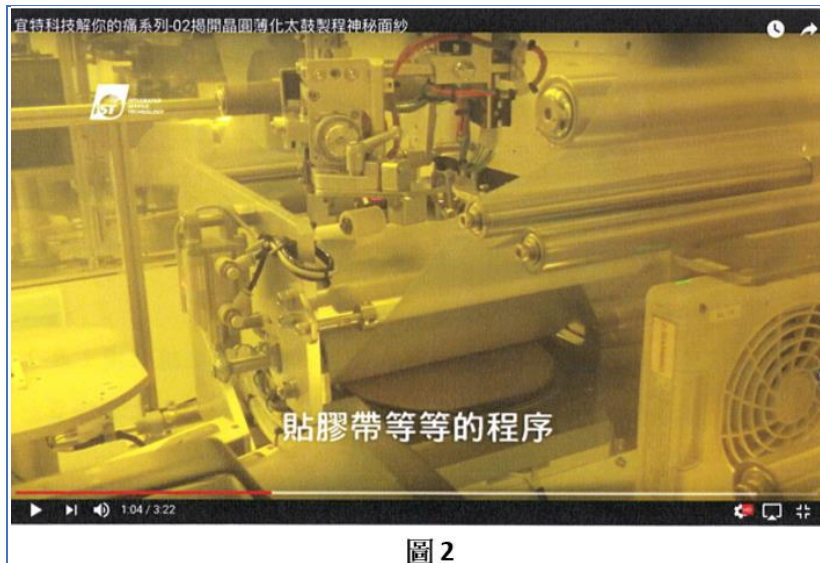


圖 2

3.



圖 3

4.

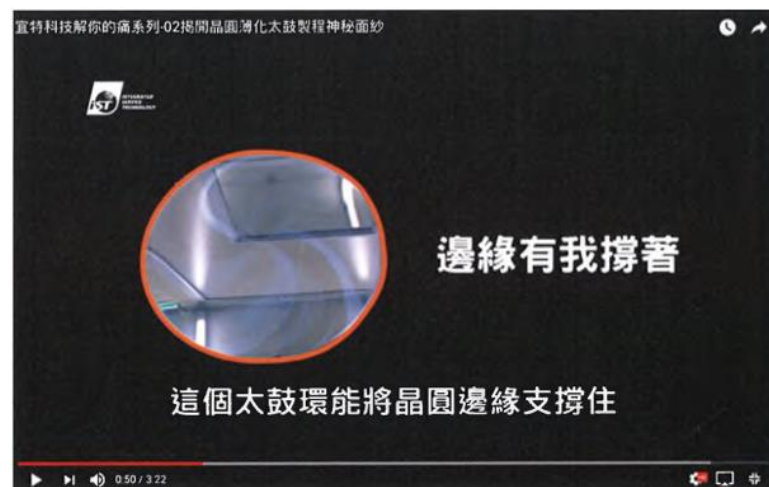


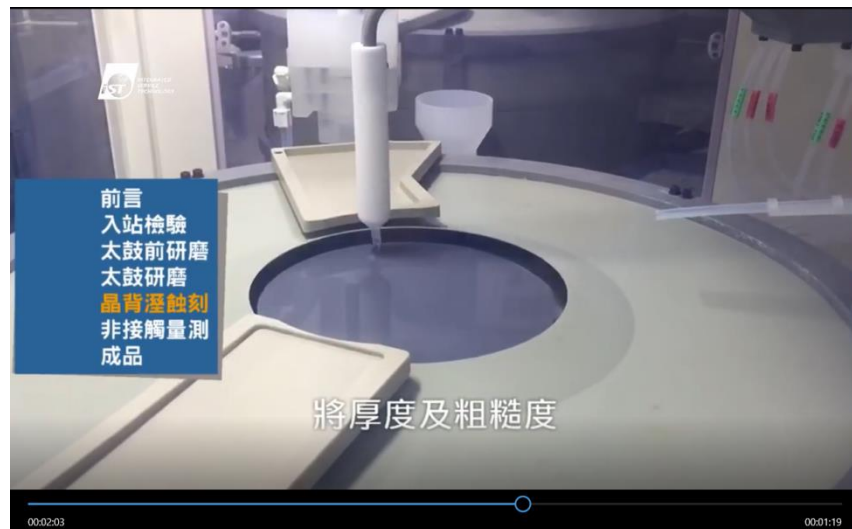
圖 4

5.



圖 5

5-1.



5-2.



6.

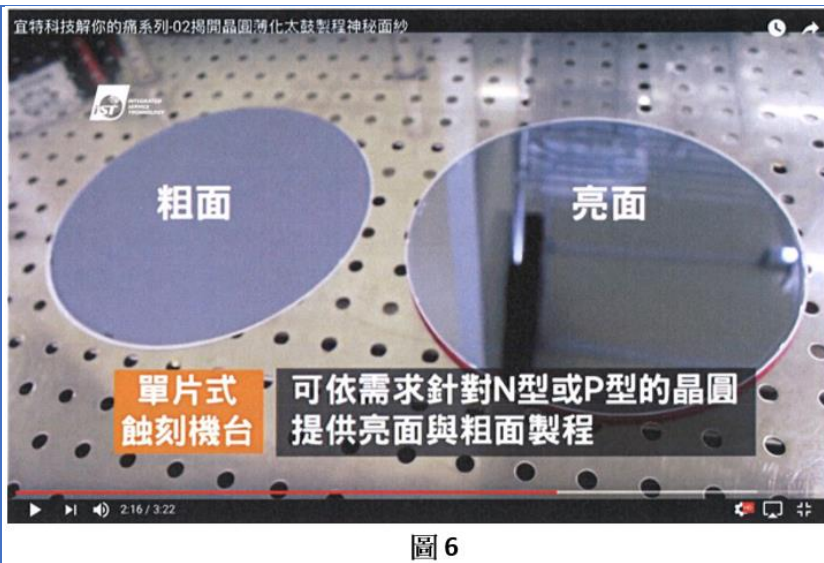


圖 6

7.



圖 7

8.



圖 8

9.



附圖三：乙證 1 圖式

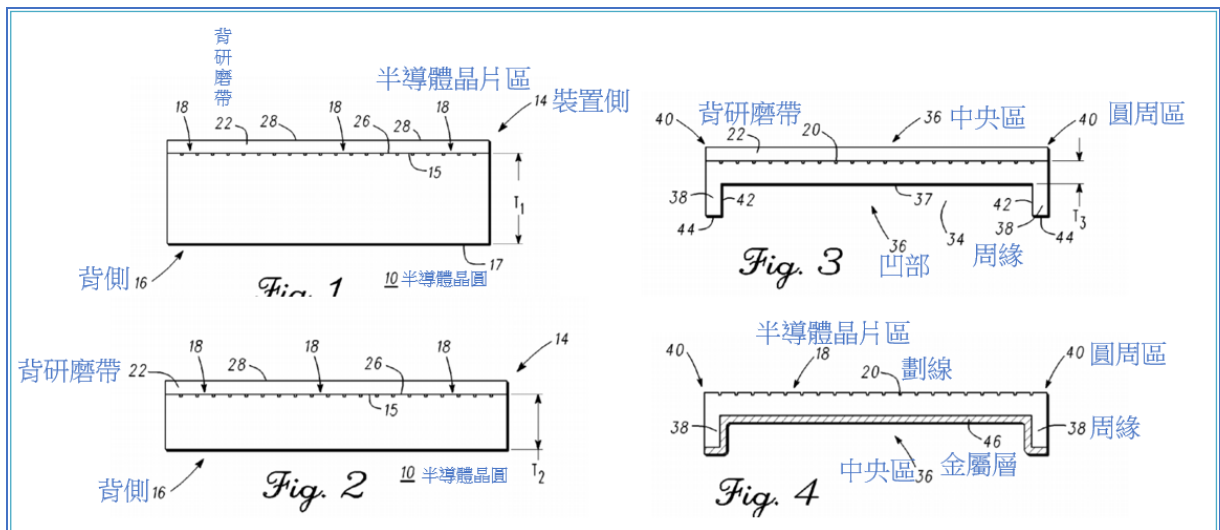


圖 1 至 4 半導體晶圓製造階段的剖視

附圖四：乙證 14 圖式

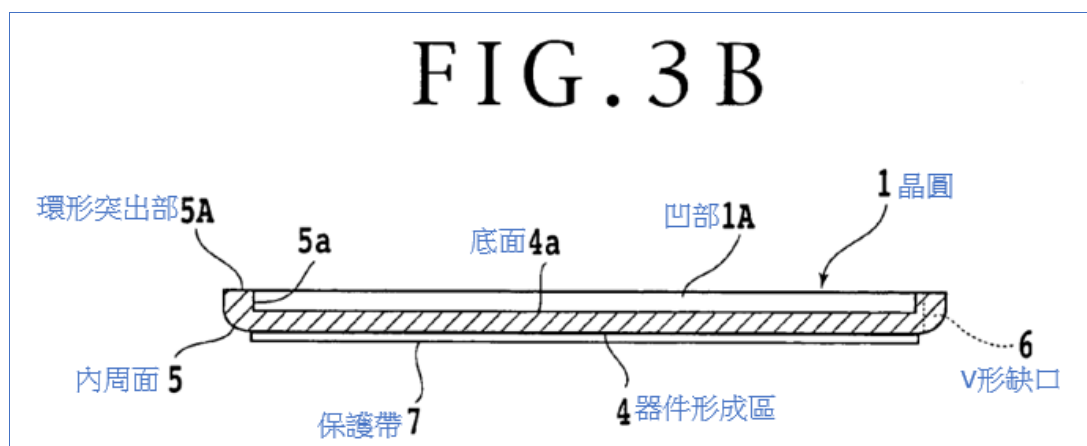


圖 3B 通過晶片研磨設備在其背面上形成具有凹部的晶圓的部視圖

附圖五：乙證 24 圖式

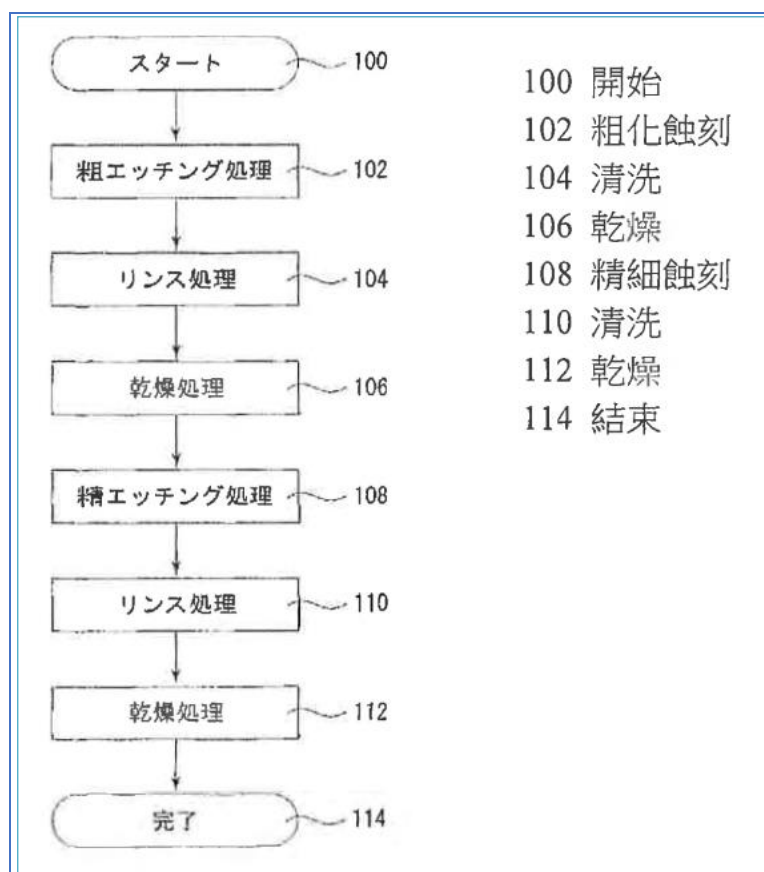


圖 1 晶圓粗化表面的製程的流程圖

附圖六：乙證 25 圖式

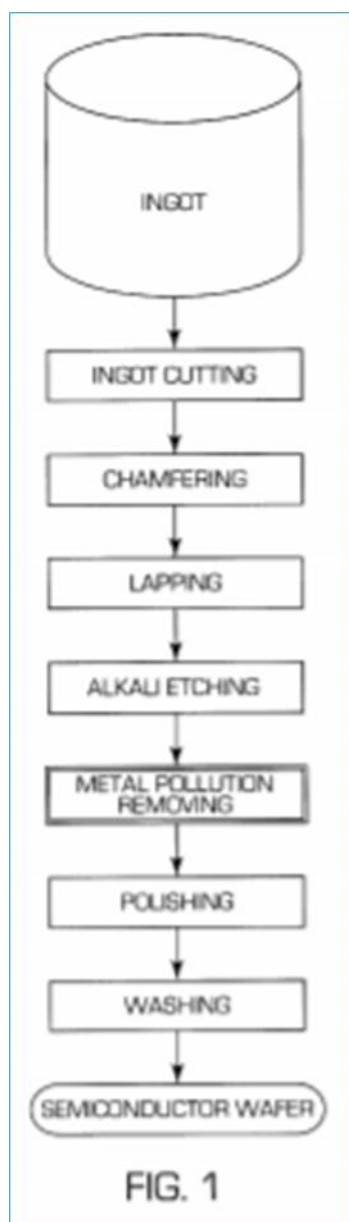


圖 1 半導體晶圓之製法

附圖七：乙證 26 圖式

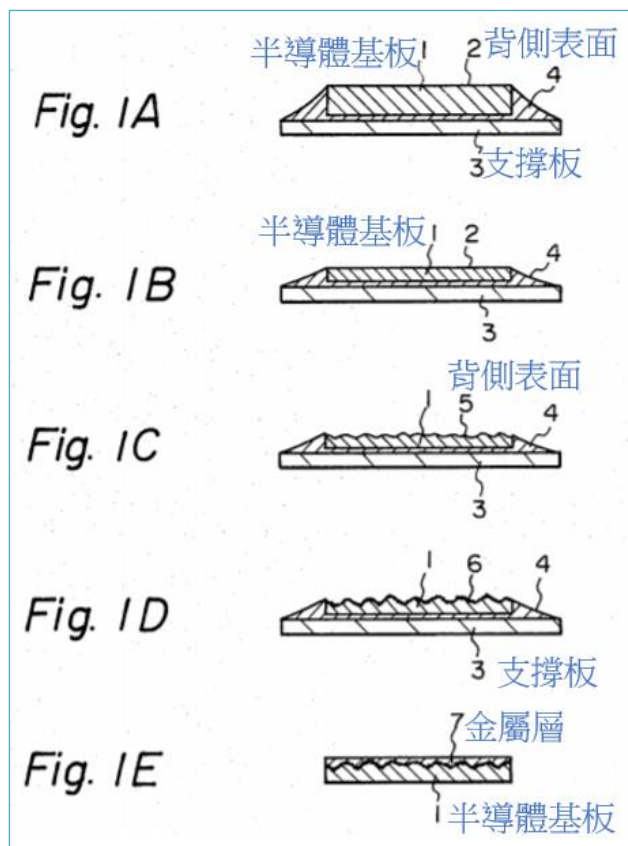


圖 1 表面處理半導體基板之方法